



主要用途

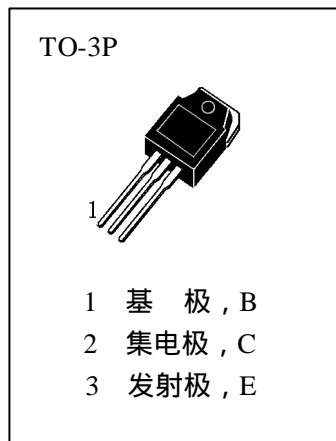
高压快速开关

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25$)	65W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	1100V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	800V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	7V
I_C ——集电极电流 (DC)	3A
I_C ——集电极电流 (脉冲)	10A
I_B ——基极电流.....	1.5A

电参数 ($T_a=25$)

外形图及引脚排列



参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测试条件
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	800			V	$I_C=5mA, I_B=0$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	1100			V	$I_C=1mA, I_E=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	7				$I_E=1mA, I_C=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			10	μA	$V_{EB}=5V, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			10	μA	$V_{CB}=800V, I_E=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	10		40		$V_{CE}=5V, I_C=0.2A$
$H_{FE}(2)$		8				$V_{CE}=5V, I_C=1A$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			2	V	$I_C=1.5A, I_B=0.3A$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和压降			1.5	V	$I_C=1.5A, I_B=0.3A$
f_T	特征频率		15		MHz	$V_{CE}=10V, I_C=0.2A$

分档及其标志

N	R	0
10—20	15—30	20—40

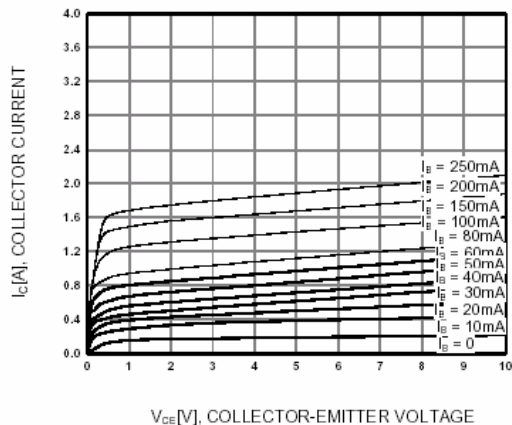


Figure 1. Static Characteristic

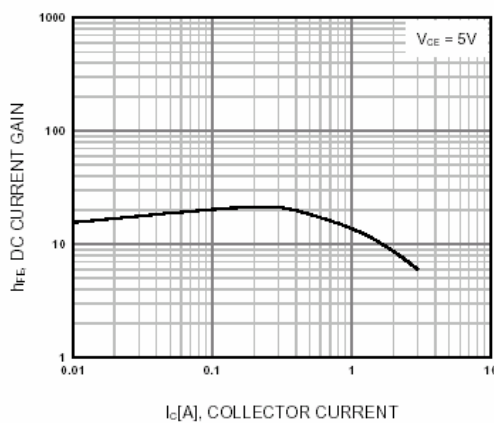


Figure 2. DC current Gain

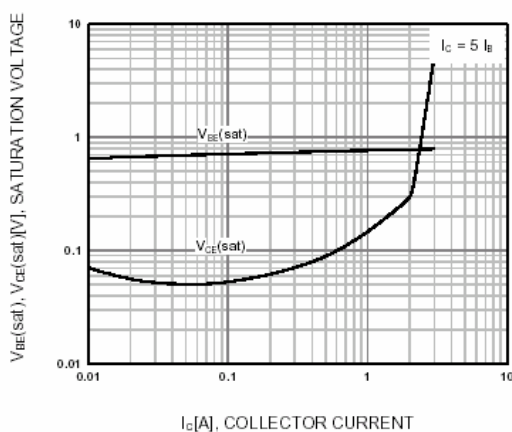


Figure 3. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage

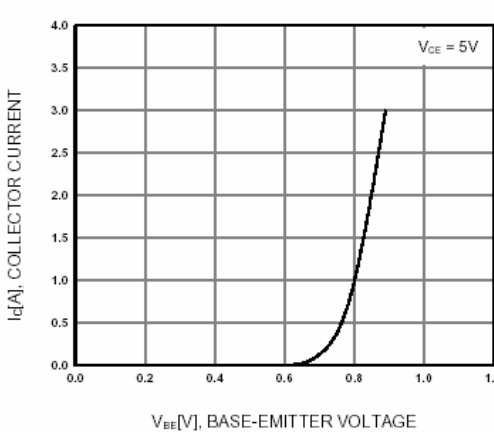


Figure 4. Base-Emitter On Voltage

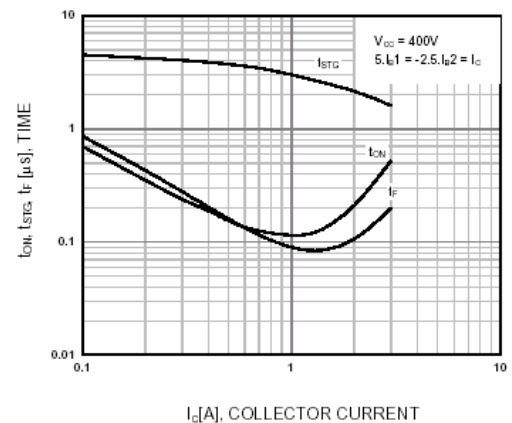


Figure 5. Switching Time

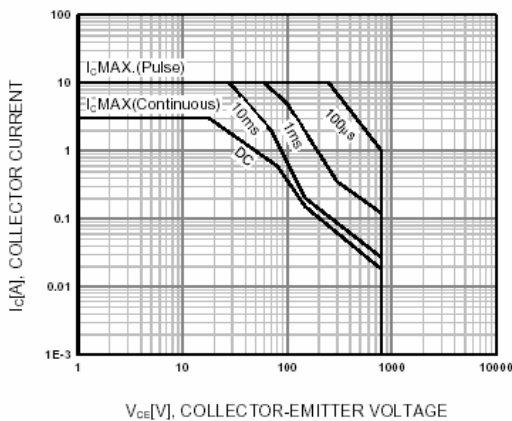


Figure 6. Safe Operating Area



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HC5027H

对应国外型号
KSC5027

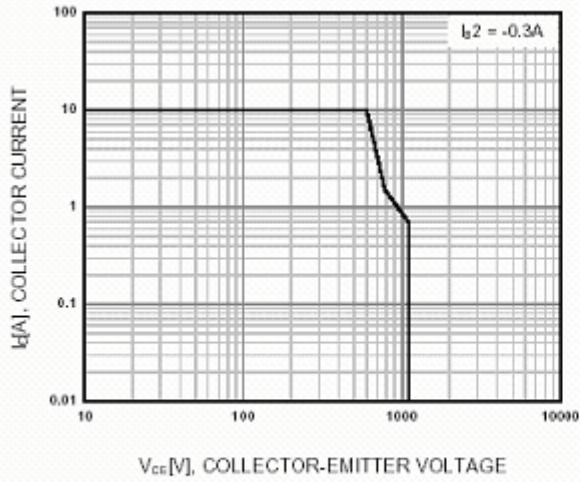


Figure 7. Reverse Bias Operating Area

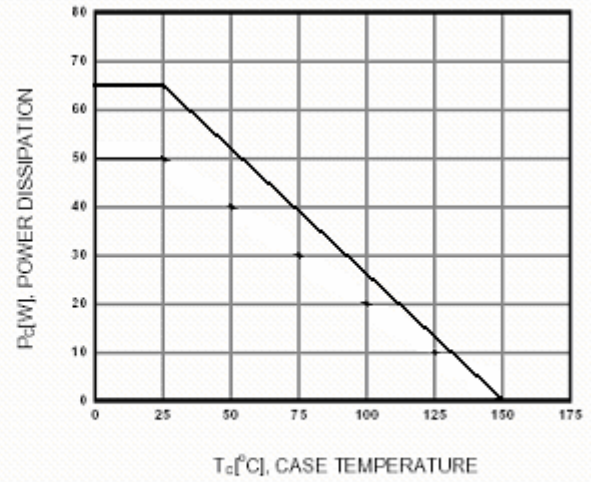


Figure 8. Power Derating